

# IMB3

## アイソレーテッドミニモールドデバイス インバータドライバ/Inverter Driver Isolated Mini-Mold Device

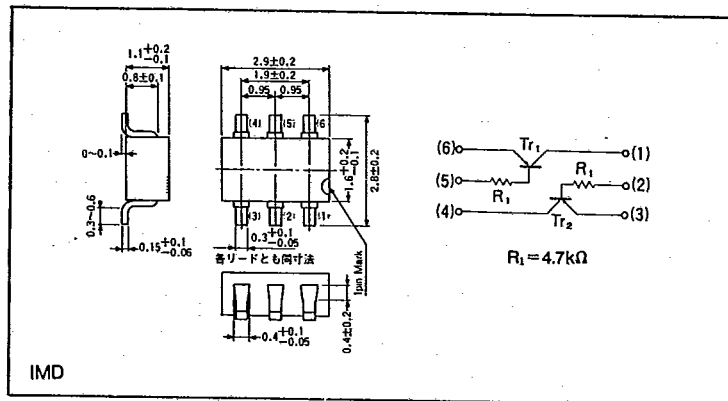
## ● 特長

- 1) SMT (SC-59) と同一体積に2個のトランジスタが入っている。
- 2) SMTの自動装着機により、装着が可能である。
- 3) 2個のトランジスタの特性がそろっている。
- 4) 各トランジスタの素子間は独立しているため相互干渉がない。

## ● Features

- 1) Two transistors are housed in the same volume as SMT (SC-59).
- 2) The automatic mounting machine of SMT can be used for mounting.
- 3) The characteristics of 2 transistors are uniform.
- 4) No mutual interference exists between each transistor.

## ● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



トランジスタ

IMDタイプ

以下の特性は  $Tr_1, Tr_2$  について共通です。/ The following characteristics are common for  $Tr_1, Tr_2$ .

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CBO}$	-50	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	-50	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	-5	V
コレクタ電流	$I_C$	-100	mA
コレクタ損失	$P_C$	300 (TOTAL)*	mW
接合部温度	$T_J$	125	$^\circ\text{C}$
保存温度範囲	$T_{stg}$	-55~125	$^\circ\text{C}$

\* ただし、1素子当り200mWをこえないこと。/However, 200mW should not be exceeded per element.

● 電気的特性/Electrical Characteristics ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・エミッタ降伏電圧	$BV_{CEO}$	-50	-	-	V	$I_C=-1\text{mA}$
コレクタ・ベース降伏電圧	$BV_{CBO}$	-50	-	-	V	$I_C=-50\mu\text{A}$
エミッタ・ベース降伏電圧	$BV_{EBO}$	-5	-	-	V	$I_E=-50\mu\text{A}$
コレクタシャ断電流	$I_{CBO}$	-	-	-0.5	$\mu\text{A}$	$V_{CB}=-30\text{V}$
エミッタシャ断電流	$I_{EBO}$	-	-	-0.5	$\mu\text{A}$	$V_{EB}=-4\text{V}$
直流電流増幅率	$h_{FE}$	100	250	600	-	$V_{CE}/I_C=-5\text{V}/-1\text{mA}$
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	-	-	-0.3	V	$I_C/I_B=-5\text{mA}/-0.25\text{mA}$
入力抵抗	$R_1$	-	4.7	-	k $\Omega$	-

T-43-90

● 標準品・準標準品一覧表 (○: 準標準品)

Type	包装名	テーピング
	記号	T110
	基本発注単位(個)	3 000
IMB3		○

● 電気的特性曲線/Electrical Characteristic Curves

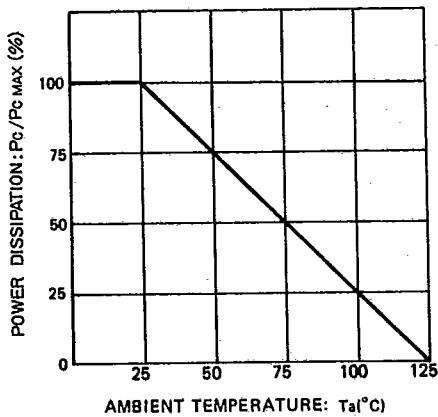


Fig.1 電力軽減曲線

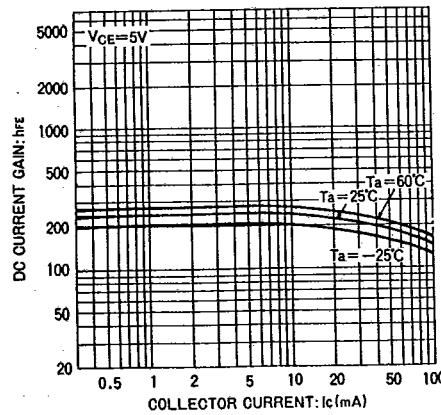


Fig.2 直流電流増幅率—コレクタ電流特性

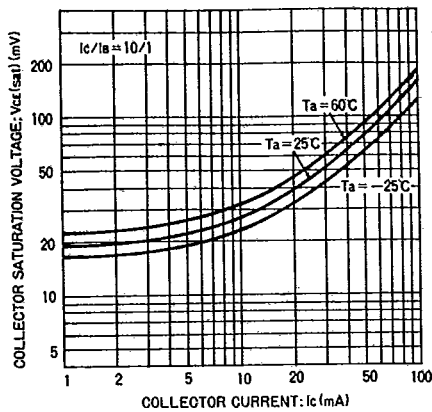


Fig.3 コレクタ・エミッタ飽和電圧—コレクタ電流特性